

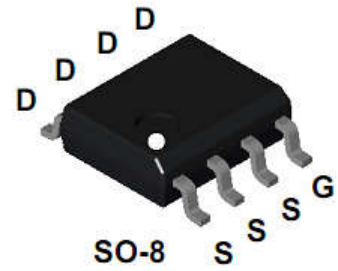
## LYNM8714SP（进口芯片）型 N 沟道 MOS 场效应晶体管

### 特性

- 参照执行标准：QZJ840611，Q/RBJ1019QZ-2015
- 封装形式：S0-8
- 开关速度快，输入阻抗高，驱动功耗小，安全工作区宽，温度稳定性好
- 产品为非国产化

### 极限参数

- 贮存温度  $T_{stg}$ ：-55℃~150℃
- 工作温度  $T_{amb}$ ：-55℃~125℃
- 焊接温度不超过 260℃，焊接时间不超过 10 秒



器件型号	额定功率 $P_D$ (W)	漏源电压 $BV_{DSS}$ (V)	栅源电压 $V_{GS}$ (V)	漏极电流 $I_D$ (A)	导通电阻 $R_{DS}$ (mΩ)	热阻 $R_{th(j-A)}$ (°C/W)
LYNM8714SP	2.5 ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )	30	±20	14 ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )	8.7	50

### 主要电特性 ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	30	—	—	V
零栅压漏极电流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V$	—	—	1.0	$\mu A$
		$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V, T_j=125^\circ\text{C}$	—	—	150	$\mu A$
正向栅极漏电流	$I_{GSSF}$	$V_{GS}=20V, V_{DS}=0V$	—	—	100	nA
反向栅极漏电流	$I_{GSSR}$	$V_{GS}=-20V, V_{DS}=0V$	—	—	-100	nA
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$	1.35	—	2.35	V
导通电阻	$R_{DS(on)1}$	$V_{GS}=10V, I_D=14A$	—	—	8.7	mΩ
	$R_{DS(on)2}$	$V_{GS}=4.5V, I_D=11A$	—	—	13	mΩ
跨导	$g_{FS}$	$V_{DS}=15V, I_D=11A$	71	—	—	S
电容	$C_{ISS}$	$V_{DS}=15V, V_{GS}=0V, f=1.0\text{MHz}$	—	1020	—	pF
	$C_{OSS}$	$V_{DS}=15V, V_{GS}=0V, f=1.0\text{MHz}$	—	220	—	pF

SO-8 封装尺寸图:

